







	<h2>SIRA04DP-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIRA04DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter: 1.SIRA04DP-T1-GE3.pdf 2.SIRA04DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 46226 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIRA04DP-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	46226 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Vgs (Max)	+20V, -16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.15 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	5W (Ta), 62.5W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3595pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	77nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40A (Tc)

SIRA04DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIRA04DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIRA04DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIRA04DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIRA06DP VISHAY VISHAY DFN56</p>	 <p>SIRA04DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>	 <p>SIRA10BDP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 30V</p>	 <p>SIRA02DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 50A PPAK SO-8</p>
 <p>SIRA02DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 50A PPAK SO-8</p>	 <p>SIRA06DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>	 <p>SIRA01DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V POWERPAK SO-8</p>	 <p>SIRA04DP VISHAY VISHAY DFN56</p>

SIRA04DP-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

SIRA04DP-T1-GE3	SIRA04DP-T1-GE3	SIRA04DP-T1-GE3	SIRA04DP-T1-GE3	SIRA04DP-T1-GE3
SIRA04DP-T1-GE3 / Siliconix	SIRA04DP-T1-GE3 Datenblatt	SIRA04DP-T1-GE3 -Datenblätter	SIRA04DP-T1-GE3 PDF	SIRA04DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix
SIRA04DP-T1-GE3 Electronic	SIRA04DP-T1-GE3 -Komponenten	SIRA04DP-T1-GE3 -Verteiler	SIRA04DP-T1-GE3 -Bild	SIRA04DP-T1-GE3 -Teil
SIRA04DP-T1-GE3 Preis	SIRA04DP-T1-GE3 Hersteller	SIRA04DP-T1-GE3 Bild	SIRA04DP-T1-GE3 Aktie	SIRA04DP-T1-GE3 Inventar
SIRA04DP-T1-GE3 Neu	SIRA04DP-T1-GE3 Original	SIRA04DP-T1-GE3 garantiert	SIRA04DP-T1-GE3 RFQ	SIRA04DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited